## Imperfecciones en el Arreglo Atómico.

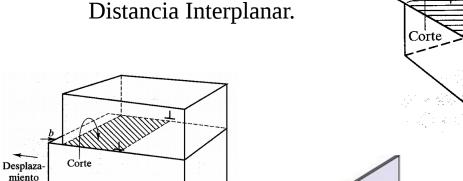
Hay tres tipos básicos de imperfecciones de red:

Desplazamiento

Núcleo de la dislocación y "línea" de la dislocación

- •Defectos Lineales (Dislocaciones).
- Defectos Puntuales.
- •Defectos de Superficie.

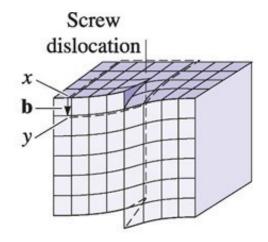
Vector de Burgues (**b**): Distancia de Repetición o Distancia Interplanar.



Dislocación de Borde.

Las dislocaciones son imperfecciones lineales en una red que de otra forma sería perfecta.

Dislocación de Tornillo.



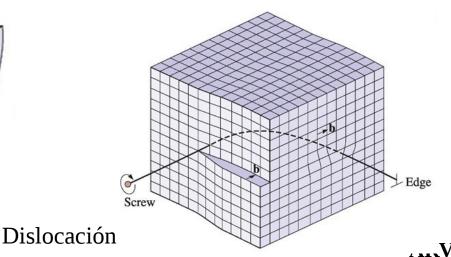


TABLA 4-2 Resumen de factores que afectan el deslizamiento en estructuras metálicas

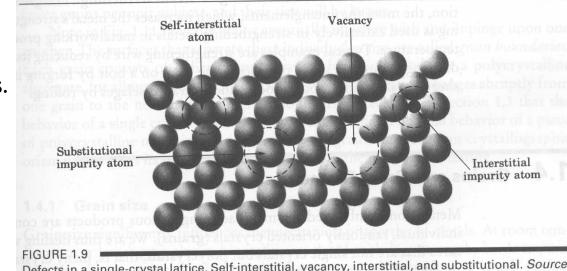
| Esfuerzo cortante resultante crítico (psi) | 50–100        | 5,000-10,000  | 50-100'              |
|--|---------------|---------------|----------------------|
| Número de sistemas<br>de deslizamiento     | 12            | 48            | 3°                   |
| Deslizamiento cruzado                      | Puede ocurrir | Puede ocurrir | No puede ocurrir     |
| Resumen de propiedades                     | Dúctil        | Resistente    | Relativamente frágil |

- •Esfuerzo Cortante Crítico.
- •Número de Sistemas de Deslizamiento.
- •Deslizamiento Cruzado.

#### **Defectos Puntuales.**

Son discontinuidades de la red que involucran uno o quizá varios átomos.

- •Vacancias.
- •Defecto Interticial.
- Defecto Sustitucional.
- Defectos Frenkel.
- Defectos Schottky.



Defects in a single-crystal lattice. Self-interstitial, vacancy, interstitial, and substitutional. *Source*: After Moffatt et al.

<sup>&</sup>lt;u>Influencia de la</u> <u>Estructura Cristalina.</u>

#### Ecuación de Arrhenius

$$n_{v} = n \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

$$n = \frac{\#\_\acute{a}tomos \times celda}{Volumen \_celda}$$

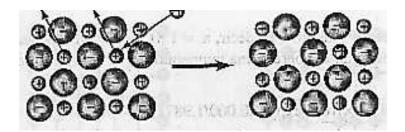
n<sub>v</sub> número de vacancias por cm<sup>3</sup> n número de puntos de red por cm<sup>3</sup> Q energía requerida para producir una vacancia en cal/mol R constante de los gases, 1.987

K\*cal/mol

T temperatura en K

Plano (100)

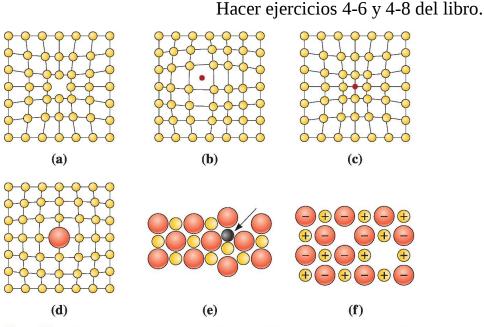
Sitio intersticial



**Defecto Frenkel** cuando un ion salta de un punto normal de la red a un sitio intersticial, dejando una vacancia.

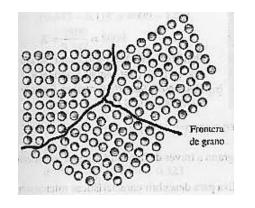
**Defecto Schottky** cuando falta tanto un anión como un catión. Se presenta en materiales cerámicos de enlace iónico.

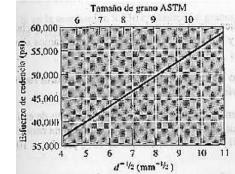
**Defecto de Reemplazo** de un ion de valencia +1 por otro ion de valencia +2.



**Figure 4-1** Point defects: (a) vacancy, (b) interstitial atom, (c) small substitutional atom, (d) large substitutional atom, (e) Frenkel defect, and (f) Schottky defect. All of these defect disrupt the perfect arrangement of the surrounding atoms.

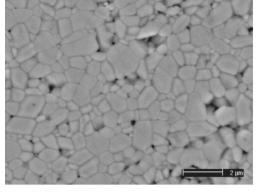
### <u>Defectos de Superficie.</u>





# Ecuación de Hall-Petch

$$\sigma_{y} = \sigma_{0} + Kd^{-\frac{1}{2}}$$



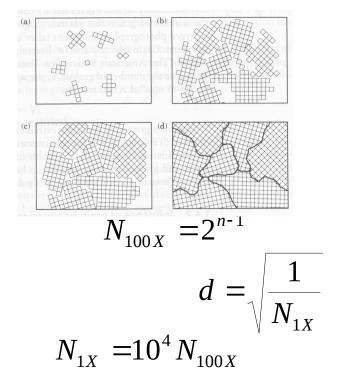
Microstructure of an alumina ceramic. (Courtesy of Dr. Richard McAfee and Dr. Ian Nettleship.)

**Metalografía** proceso de preparar una muestra, observar y registrar su microestructura.

Número de Tamaño de Grano ASTM cantidad de granos a 100X en 1 in<sup>2</sup>.

Bordes de Grano de Ángulo Pequeño no bloquean eficientemente el deslizamiento (bordes inclinados, bordes torcidos).

 $\sigma_{\rm v}$  esfuerzo de cedencia d diámetro promedio de los granos  $\sigma_0$  y K constantes del metal



American Society for Testing & Materials (ASTM)